\mathcal{O}

ELECTROPHORESIS DEVICE

Publication number:

JP1196834 1989-08-08

Publication date: Inventor:

SUZUKI KENJI FUJI ELECTRIC CO LTD

Applicant: Classification:

FOULEECT KIC CO LTD

- international: - European: H01L21/316; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/316

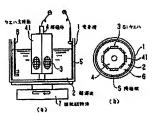
Application number: Priority number(s):

JP19880022234 19880202 JP19880022234 19880202

Report a data error here

Abstract of JP1196834

PURPOSE: To form a passivation film having a small air bubble rate by securing the cathode of an electrophoresis device to the center of a vessel and the anode to the inner wall of the vessel, and rotating the vessel. CONSTITUTION: An anode plate 5 is extended inside a cylindrical electrodeposition tank 1, and a cathode 4 having the supporting face 41 of a octagonal columnar semiconductor wafer 3 is secured to the periphery of a central shaft connected to a power source in the bottom. The tank 1 is rotated by a drive source 7 with the cathode as a center. After the wafers 3 are attached to the supports 41, isopropyi aicohol suspended with fine glass powder is poured in the tank 1, a voltage is applied between both electrodes 4 and 5, the tank 1 is rotated while blowing ammonia gas from a gas tube 6 to perform an electrophoresis method. Only fine glass particles disposed at the small center of centrifugal force is deposited on the wafer 3 supported on the cathode 4. A passivation film having small air bubble rate is formed.



(9) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平1-196834 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 4

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成1年(1989)8月8日

H 01 L 21/316

6708-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

雷気泳動装置 50発明の名称

> 頭 昭63-22234 20特

願 昭63(1988)2月2日 @1H

冒 70発 明 者

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 补内

富士電機株式会社 勿出 願 人 弁理士 山 口 加代 理 人

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

1,発明の名称 電気泳動装置

2. 株 許 肄 求 の 節 開

1) ガラス微粉末想樹液を収容する円筒状容器が軸 心の周りに回転可能であり、該容器の軸心部に外 面に半導体素体を支持する陰極体、容器の周壁内 丽に臨路板がそれぞれ間定されたことを特徴とす る電気泳動装置。

3. 発明の詳細な説明

(南華上の利用分野)

本発明は、半導体素子の表面安定化のためにガ ラス微粉末を付着させパッシベーションを行うた めに用いる電気泳動装置に関する。

〔従来の技術〕

パッシベーション材料としてガラスを用いる場 合、従来は電気泳動法によりガラス微粉末を半導 体素体表面に付着させる方法が、その後の焼成で 均一なガラス膜を形成できるので採用されている。 第2回はそのための装置を示し、電着権1の中に ガラス微粉末をアルコールに懸濁させた被2を収

容し、この液中に半導体ウェハ3を支持した陰極 版4とそれに平行に対向する陽極板5を浸漬し、 アンモニアガスを導入管 6 より噴出させながら再 電極間に直流電圧をかけることにより電気泳動法 を行う。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、第2図のような装置で電気泳動法を 行うと、粒径の大きい例えば10mを超える径のガ ラス粉末も半導体ウェハ3に付着しやすく、焼成 時に空隙の少ない滑らかなパッシベーション誰が できにくいため、特性の安定した素子が製造しに くいという欠点があった。しかもこの現象は、処 即枚数が増加するほど顕著になるため、処理枚数 が制限され、装置の利用効率を高めることができ なかった。粒径の大きい粉末を付着させないため には、アルコールに懸濁させるガラス粉末を從田 化すればよいが、そのためにはグラインド作業を 多くしなければならず、不能物が多く入る欠点が 生ずる。

本発明の課題は、粒径の大きいガラス粉末も混

じた 懇懇後 年用いても、比較的 粒径の小さいガラス 粉末を選択的に 半導体素体の実際に付着させる ことができ、空隙の少ない滑らかなパッシベーション限を形成して特性の安定した半導体素子の製 でに関いることのできる電気泳動装置を提供する ことにある。

(課題を解決するための手段)

上記の課題を解決するために、本発明の設置は が うス 欲粉末整瀬後を収容する円筒状容器が輸ん の 周 りに回転可能であり、容器の輸心部に外面に 平準 体 無保 を 支持する 除極 体、容器の 関 壁 内 関 に 階 極 版 を 固 定 き れたもの と する。

(作用)

ガラス数粉末想増減を収容した容器を囲転させることにより、遠心力で粒径の大きいガラス粉末 が容器の外限に移動し、容器の回転中心部に位置 する階層体の外限にある半導体業体には粒径の小さいガラス粉末だけが付着する。

(実施例)

第1図(a), (b)は本発明の一実施例を示し、(a)は

時に空間が少なく気他率の少ない待らかなバッシベーション間が得られた。その結果、逆方向のもれて設か小さく、逆方向特性のソフトなものが少なくなって耐圧が向上し、組立後の高温電圧印加 試験でもソフトな逆方向特性に劣化するものも少なくなった。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図(4), (5)は本発明の一実施例の装置を示し

断面図、GUは平面図であり、第2図と共進の部分 には同一の符号が付されている。円筒状の電岩槽 1には内側に陽極板5が張られており、座面には 電源に接続される中心軸の用りに八角柱状の半導 体ウェハ3の支持原41を有する降極体 4 が固定さ れている。陽極板 5 と支持面 41の間隔 は 2 ~ 4 cm とする。この電着槽1は駆動源でにより除極体を 中心として回転させることができる。既にエッチ ングによりメサ溝を形成したウェハ3をこの猛躍 の各支持面41に取付けたのち、ガラス微粉末を料 濁させたイソプロビルアルコールを捜1内に入れ、 両極 4 、 5 間に 50~500 V の 直流 電圧を 印加 し、 ガス導入管6からアンモニアガスを吹き込みなが 6、電着槽を20~200romの回転数で回転させて容 気味動法を行う。このあとメサ準の内面を除くっ エハ面に付着したガラス粉末を除去してから焼成 を行うと、メサ津内に露出したPN接合を保護す るガラスパッシベーション嫌が得られる。

第1 図の装置により電気泳動法により付着した ガラス微粒子は粒径が7~8 m以下であり、地位

(a) は断層図、(b) は平面図、第2図は従来装置の断面図である。

1:電春橋、2:ガラス微粒子懸濁液、3:シ リコンウエハ、4:除極体、41:ウェハ支持面、 5:隔極柄、7:同転駆動調。

化以入州过士山口 数



